```
** Result [P ] ** Format(P805) 2006.02.03
                                                   1/
                                          1980-113515[1980/ 8/20]
Application No./Date:
                                          1981- 37834 Translate [1981/ 4/11]
Public Disclosure No./Date:
                                              1282844 [1985/ 9/27]
Registration No./Date:
Examined Publication Date (present law):
Examined Publication No./Date (old law): 1984- 9086 Translate [1984/ 2/29]
PCT Application No.:
PCT Publication No./Date:
                                                      [
                                                                 ]
Preliminary Examination:
                                           ()
                                            ] (
Priority Country/Date/No.: ( ) [
Domestic Priority:
                                                      [1980/ 8/20]
Date of Request for Examination:
                                           ( )
Accelerated Examination:
                                           (8000)
Kind of Application:
                                                      [1979/ 7/20](S)
Critical Date of Publication:
No. of Claims:
                                           ( 1)
Applicant: HITACHI LTD
Inventor: AIKI KUNIO, OSHIMA MASAHIRO
                                               =G06K 7/10
IPC: G11B 7/12
                          =G02B 27/00
  =H01S 3/096
      G06K 7/10
                                             G02B 27/00
                        C H01S
 G11B 7/09
                   B G11B 7/125
                                      A H01S 5/00
F-Term:
5F073AA15,BA04,EA01,EA27,GA38,5B072CC16,DD02,HH20,LL12,5D118AA23,CB07,
5D119AA17, AA19, BA01, BB01, FA05, HA12, HA14, HA38, HA40, HA41, HA68, 5D118DA25, 5D789A
   A17, AA19, BA01, BB01, FA05, HA12, HA14, HA38, HA40, HA41, HA68
Expanded Classicication: 425,422,446
Fixed Keyword: R002,R102
Citation: [ ,
                                   ] ( , ,
                                                    )
```

Abstract: PURPOSE: To obtain an optical pickup that generates no noise by permitting a semiconductor laser to oscillate infixed multiplex longitudinal mode. CONSTITUTION: Semiconductor laser 1 is driven by electric current supplied from two electric power sources, DC electric power source 5 and high-frequency current source 6, to provide multiplex longitudinal mode oscillation and laser light that corresponds to the oscillation spectrum focuses on video disk 2 through condenser lenses 41 and 42 to pick up information on disk 2. Through this multiplex longitudinal mode oscillation, a light output varies smoothly against displacement due to the flopping of disk 2 and fluctuations of the light output in which the displacement of disk 2 happens at intervals of  $\lambda/2$  are suppressed, suppressing a low frequency range noise perfectly. Here,  $\lambda$  represents the wavelength of the laser light. Simultaneously, the high-frequency driving multiplex longitudinal mode oscillation reduces the video noise level, so that an optical pickup can be obtained which generates no noise.COPYRIGHT: (C)1981,JPO&Japio

Title of Invention: OPTICAL PICKUP

## **爾日本国特許庁(JP)**

⑪特許出願公告

#### ⑫特 許公 藝(B2) 昭59-9086

@Int.Cl.3 G 11 B G 02 B 7/12 G 06 K H 01 S

**庁内整理番号** 識別記号

**匈匈公台 昭和59年(1984)2月29日** A-7247-5D

6952-

発明の数 1

(全7頁)

1

# **90光学的情報再生裝置**

20特 頤 昭55-113515

您出 顧 昭54(1979) 7月20日

3/096

(前実用新案出顋日援用)

63公 爾 昭56--37834

鐵蝦56(1981) 4 月11日

179発 明 者 相木 国男

国分寺市東恋ケ海1丁目280番地 株式会社日立製作所中央研究所内 10

700 発明 者 尾島 正啓

国分寺市東恋ケ森1丁目 280 養地 株式会社日立製作所中央研究所内

⑪出 願 人 株式会社日立製作所・

6番地

四代 理 人 弁理士 高橋 明夫 外2名

## の特許諸求の範囲

1 情報記録媒体上にレーザ光を照射するための 半導体レーザ素子と、該情報記録媒体からの反射 光を利用して該情報記録媒体に記録された情報に 対応する電気信号を得るための光電変換手段とか らなる光学的情報再生装置において、上記半導体 で発振する半導体レーザ素子であると共に、該半 導体レーザ素子が多重様モードで発掘するように 上記直流電流に重畳される高周波電流を供給する 高周波電流源を有することを特徴とする光学的情 報再生裝置。

- 2 上記高周波電流の高波数は、上記情報記録媒 体に記録された上記情報の題波数の5倍以上であ ることを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の 光学的情報再生藝聞。
- 3 上記高周波電流の周波数は、50 MHz以上で 35 レーザ発掘が起こる。 あるととを特徴とする特許請求の範囲第1項記載 の光学的情報再生装置。

### 発明の詳細な説明

本発明は、光学的に情報を再生する光学的情報 再生装置、特に半導体シーザを光源として用いた 光学的情報再生装置に関する。

2

光ビデオアイスクや光PCMオーアイオデイス クから光学的に情報を再生する情報再生装置には、 光浪として半導体レーザを用いた光学的ピツクチ ップが用いられる。この光学的ピツクアップには 従来二種類のものがある。

その第1は、情報記録媒体からの反射光を光源 たる半減体レーザに帰還することにより、反射性 の変化を半導体シーザの出力光の変化に変換し、 この出力光の変化を受光器で検出することによつ て記録情報に対応した電気信号を得るものである。 東京都千代田区神田駿河台 4 丁目 15 との光学的ピックアツブは、いわゆる SCOOPで (Self-Coupled Optical Pickup) と呼ば れている。

第1図は、上記 SCOOP による情報再生装置の 郷略構成図である。 1 は半導体レーザ、 2 は情報 記憶媒体を有するデイスクである。その媒体は例 えば円板状の基板に設けられており、凹凸あるい は反射率変化として、情報を記録する。3は光検 出器、41は半導体レーザからの光を平行光東に するためのレンズ、42はレーザ光を、デイスク レーザ索子が、直流電流駆動により単一縦モード 25 2の表面上で、光の波長程度の長さのスポット径 に集光するためのレンズである。この装置では、 半導体レーザ1から射出されたレーザ光はレンズ 41,42によりデイスク2上の情報記憶媒体に 照射され、記録情報に応じた変調を受けて反射さ 30 れる。この変調された反射光は同じ光路を戻り半 導体レーザ1に帰還される。デイスク2が半導体 レーザの発振器の一部になつていることが特徴で ある。即ち半導体結晶の2つのへき頭と、デイス ク2との、3枚の鏡でつくる光共復器によって、

> この装置に於ては、デイスク2からの反射光の 光量の変化に応じて半導体レーザの発振光出力が

変化するので、この発振出力光の変化を光検出器 3で検出することにより反射光の変化を検出して デイスクに記録されてある情報信号に対応した電 気信号を得る。この装置の特徴は、構成部品点数 が少なくて済むので、小型化、軽量化、低価格化 5 を特徴とするものである。 ができ、更に光学調整が容易な点にある。一方、 この方式の欠点の一つに、信号の殺者レベルが高 い事があげられる。

第2の光ピツクアツブは、上記光デイスクから の反射光を半導体レーザに帰還することなく、直 10 れない場合に、横モードが制御された半導体レー 接光検出器で受光することにより記録情報に対応 した電気信号を得るものである。この第2の光ピ ツクアツブは、例えば第1図に示す装置において 説明すれば、次のように構成される。即ち、光デ イスク2からの反射光が、半導体レーザ1に帰還 15 一つの縦モードに、レーザ光エネルギーが築中す されないように、半導体レーザーとデイスク2と の間に1/4波長板と偏光プリズムを挿入するの である。この場合の光ピツクアツブを以下に於て は、従来型の光学的ピツクアツブと呼ぶことにす る。従来型の光ピンクアツプにおいても、デイス 20 に伴なつて、単一発膿縦モードが、鱗りの単一縦 クからの反射光がレーザに全く帰還しないわけで はない。 PCMオーデイオデイスクやピデオディ スクでは髙分子樹脂を用いて、レプリカデイスク を大量生産するが、レブリカ成型時に生じる応力 のために、レプリカデイスクはわずかな複歴折性 25 を持つ。従つて、従来型光ピックアップでレプリ カデイスクから情報再生する場合には、レブリカ デイスクの持つ複屈折性のために、デイスクから の反射光の一部が、半導体レーザに帰還される。 更に1/4波長板や偏光プリズムの光学的調整ず 30 共振モードスペクトルが変化することによって引 れや、邪品性能のぼらつき等の原因によっても、 デイスクからの反射光が、半導体レーザに帰還さ れる。結局、従来型のピツクアツブにおいても、 デイスクからの反射光の数%は、半導体レーザに 帰還され、レーザの雑音レベルを高くしてしまう。35 以上を要するに、半導体レーザを用いた光ピツ クアツブでは、SCOOPでも、従来型でも、反射 光帰還による、半導体レーザのノイズ発生が問題 である。半導体レーザのノイズレベルが高いと、 PCMオーデイオプレーヤでは、音質の劣化を、 ビデオデイスクプレーヤでは画質の劣化を引き起

本発明の目的は、半導体レーザを光源として用 いた光学的情報再生装置において、上述の雑音の

とす。

発生を抑止した情報再生装置を提供するものであ る。かかる目的を達成するために、本発明は半導 体レーザを直流電流に高周波電流を重畳した電流 により駆動して多量艇モードで発掘せしめること

以下、まず半導体レーザを光源として用いた場 合に発生する雑音について詳細に説明する。 第1 図に示す装置において、デイスク2がなく、した がつて反射光の帰還が、半導体レーザーに施こさ ザを直流電流で駆動すると、単一級モード発振す る。これは半導体シーデが、ほぼ均一な利得スペ クトルを有しているために、直流電流駆動による 定常発振時には、利得が損失を上まわつた、ある るからである。

しかしながら、デイスク2が有り、反射光の帰 選が半導体レーザに施こされる場合、半導体レー ザを直流電流で駆動すると、ディスクの微小変位 モードへジャンプしたり、数本の縦モードが同時 発振したりする。反射光帰還がある半導体レーザ の雑音レベルが高い原因は、このような、発振機 モードの変化にある。

発掘縦モードの変化は、半導体レーザのデイス ク側面と、デイスク面とでつくる外部光共振器の 共振モードと、半導体結晶の2つのへを開面でつ くる光共編器の共振モード(縦モード)とが競合 し、かつデイスクの変位に伴なって外部共振器の き起こされる。

単一縦モード発振と多重縦モード発振とは、デ イスクがレーザ発掘波長の半分(*1/2*こ 0.4 gm) 変位する毎に、交互に起こる。これは、デイスク と半導体レーザ端面とがつくる外部共振器の鉄振 条件が、同一波長に対しては、 1/2年に同一に なるからである。

反射光帰還時に発生するレーザノイズには、2 種類あり、第1のノイズは、単一縦モード発銀と 40 多量縦モード発振とが、デイスクの 1/2 毎の変位 に対応して交互に起こることに原因する。単一統 モード発振時の光出力は大きく、多量緩モード発 振時の光出力は小さい。従がつて、レーザ光出力 は、デイスクが 1/2変位する毎に変化する。発

振縦モードが、単一か多重かに依つて、光出力が 異なる原因は、外部共振器を一枚の鏡とみなした 場合の有効反射率が、単一縦モード発振時は大き く多重縦モード発振時は小さいことにある。単一 縦モード 発掘は、外部共振器の有効反射率が最大 となるようなモードが選択されて起こる。 多重機 モード発振では、発振している概本かのモードの すべてについて、外部共振部の有効反射率を最大 にすることはできないので、平均としては、単一 **綾モード発提時の有効反射率より小さくなる。レ** ーザ共振器を構成する鏡の反射率が高い程、損失 は小さく、発掘しきい電流が小さくなり、一定電 流下では光出力が大きい。従つて、単一縦モード 発援時の方が、光出力は大きい。発振縦モードが 単一か多重かによる光出力変動の間波数帯域は、 デイスクと半導体レーザとの距離が、1/2変化 する速さによつて突まり、デイスクのばたつき、 回転数や自動焦点制御の性能に依存するが、ほぼ、 KHz~数10KHzの低帯域にある。

クトルノイズで、多重縦モード発援時に生じる。 ビデオデイスクからの再生で、ビデオ信号の 3/Nを劣化させる。ここでは、この2種のノイ ズをビデオ帯域ノイズと呼ぶことにする。この丿 イズは反射光帰還がある場合でも、発振縦モード 25 が単一である場合には発生しない。反射光帰還に よつて多重縦モード発振しているときに限つて、 ビデオ帯域ノイズが発生する。実際には、デイス クが 1/2変動する母に、単一様モード発掘と多 域ノイズは必ず発生する。

次に、図を用いてノイズ発生の実際を詳しく説 明する。

デイスクと半導体レーザとの間の距離が、時間 とともに変化する場合、発暖縦モードの変化に伴 35 を駆動できるようにするために挿入されている。 なう半導体レーザの光出力変動が、情報の再生信 号や、光スポツト制御信号等における信号対雑音 比を劣化させる。例えば、ディスクからの情報再 生の場合、回転に伴なうディスクのばたつきによ り、デイスクと半導体レーザとの間の距離が変化 め し、半導体レーザの光出力変動が生ずる。第2図 はこの状況を示す図である。

第2図において、健軸は、半導体レーザの光出 力(mW)を示し、機能は、デイスクのはたつきによ

るデイスク変位(sm)を示し、実線が、直流電流に よる駆動を行つた場合の光出力の変化を奏わして いる。なお、直流電流による駆動は第3図に示す 如き與線で行なわれる。第3回において、機能は 電流の大きさ(mA)、横軸は時間(nS)を示してい

**第2図において、デイスクが、光スポツト焦点** 位置から上10 μm すれると、半導体レーザ出力 が選ることを示している。これはデイスクからの 70 反射光のうち、半導体レーザの出射口に帰還され る光量が減るととによる。ディスクの 1 gm 以下 の微小な変位によって、上記の大まかな変化以外 に、 1/2年に細かな光出力変励が生ずる。これ が第1種の低帯域ノイズである。この光出力変動 は、光出力DC分の・10~20の大きさである。 光出力が落ち込んだときは、縦モード多重発掘し ており、このときビデオノイズが増加する。

光スポットの自動焦点制御によつて、光スポッ ト焦点位置を、デイスク変位に追従させることが 螭2のノイズは、0~2GHzにわたる連続スペー紐ーできる。しかしデイスクと光スポツト焦点位置と を1#m 以下の特度で一定に保つことは、自動制 御技術をもつてしても困難であり、発振縦モード の変化に伴なう光出力変動は、自動焦点制御をか けても、除くことは斃かしい。

本発明は、学導体レーザの駆動方法に特徴をも たせることにより、上記の、発振緩モードの変化 に伴なう光出力変動を抑止することである。 第4 図に、本発明の一実施例の構成を示す。第4図の 1,2,3,41,42は、蘇【図に示したもの 重縦モード発掘とが交互に起こるので、ビデオ帯 30 と同一である。半導体レーザは、直流電流源5と、 高周波電流源6と、2つの電流源から供給され る電流によって駆動される。第4図における、R, L,Cは各々、抵抗、コイル、コンデンサであり L及びCは、2つの電流源が独立に半導体レーザ 高周波交流電流によつて駆動することによつて、 反射光帰週による半導体レーザの光出力変動を抑 止することができる。なお、直流電流と髙周波電 流とによる半導体レーザ駆動は、第3回に示す如 く、直流電流(夷線で示す)に高周波電流(点線 で示す)を質覺した形式でなされる。

> かかる本発明の駆動を用いた場合の作用及び効 果について、図面により説明する。

第5図a~dは、半導体レーザの様モード発振

スペクトルを示しており、その緩離は光強度、そ の機構は波長を示している。直流電流駆動で定常 発振させ、反射光帰還がない場合は、第5回2の ように単一縦モード発振する。反射光燥温がある とデイスクが変動している場合、時間平均してス 5 ペクトルを見れば、第5図bのように多重桜モー ド発振している。

さて、第3図の点線で示したような、直流分と 高周波の交流電流とを重ね合わせた電流で半導体 レーザを駆動すると、発振スペクトルは第5図c のように多重縦モード発掘となる。ここで、重要 なことはレーザ発振が高周波でオン・オフされる ように、高剛波電流の振幅を十分大きくする必要 があることである。すなわち、直流分と高間波分 の重ね合わせた電流の最小優は、発振しきい電流 15 より小さくなるようにする。レーザ発振の立ち上 がり時には、均一なスペクトル広がりをもつ半導 体レーザにおいても、いくつかの縦モードがレー ザ発機する。従つて、髙周波でレーザ発掘がオン オフされると、多属機モード発掘状態が保たれる 20 ととになる。

高周波電流を飛すことにより、多重縦モード発 綴させると、第2図の点線で示したように、半導 体レーザの光出力はデイスク変位に対して、なめ る。すなわち、単一縦モードと多重縦モードとが 交互に起こるととによって生じる第1種の低帯域 ノイズは、完全に抑止される。高恩波駆動により 常に多重線モード発提状態が保たれ、単一線モー 下発機することはないからである。

更に高層波電流駆動により、 觞 2 種のビデオ帯 域ノイズも、かなりの程度抑止される。第5図 d は、反射光帰還があるとき高周波駆動した場合の 発報スペクトルである。 第5図aと第5図cとで はビデオノイズないが、第5図2ではビデオノイ ズ大きく、鮪5図dではビデオノイズが鮪5図b より小さくなる。

第6図は、ビデオノイズレベルが高周波駆動に よって抑止されるととを示す特性的旋図である。 なお、その被軸は反射帰還量を対数表示してある。40 使用したレーザは、CSP型 (Channeled Substrate Planer)半導体レーザで、発掘し きい電流が60mAのものである。図において、 本発明によらない場合を実設で示し、本発明によ

る場合( 直流分 75mAに対し、 1 2 0 MHz, 5 0 mAppの高周波分を重畳して変調した場合)を点 線で示してある。反射光帰還が100%のとき、 すなわち、SCOOPの場合の光ピックアップの場 合、ビデオノイズは約10dB抑止されている。 従来型の光ヘツドでも数%の反射光帰還は避けら れないが、この場合にも高局波駆励によつてビデ オノイズを抑止できることが第6図からわかる。

高周波駆動に使用する周波数に対するビデオノ 10 イズ抑止効果を第了図に示した。但し、特性曲線 はCSPレーザ、直流電流75mA変調電流振幅 50mAppでの場合を示している。第7図から周 波数は50MJI2以上でノイズ抑止効果が著しい。 これは50MHz以上で凝モード多重発綴となるか らである。なお、第7図において、実練は100 %帰還した場合を示し、一点鎖額は 0.5 %帰還の 場合を示す曲線である。

高周波駆動電流の周波数は、デイスクから再生 しようとする情報の簡波数より、十分高い層波数 である必要があることは当然である。光検出器の 周波数特性を考慮して再生情報の周波数の5倍以 上、好ましくは10倍以上となすのが好ましい。 再生情報の周波数は、ビデオデイスクやPCMオ ーデイオデイスクの場合、1~10 MHzである。 らかに変化し、1/2毎の光出力変動は抑止され 25 一方、半導体レーザを、多重縦モード発振させる ためには50MHz以上の高周波電流で駆動する必 要がある。発振器、光検出の検出回路の実用上の 観点から数100MHz程度迄を使用する。従って、 50MHz以上の高銅波電流で半導体レーザを駆動 30 すれば、多重縦モード発振によって、光出力変動 を抑止でき、かつ、デイスクからの再生信号より も、十分高い周波数なので、再生信号に不都合な影 顰を及ぼすこともない。すなわち、光検出器及び 検出回路系の、周波欲応答特性は、再生信号帝城 35 までのびており、半導体レーザ駆動の高周波域で は応答しないようにしておけばよい。

> 第8図は、ノイズ抑止効果の高圏波電流の振幅 依存性を示している。但し、第8回は、CSPレ ーザ、発掘しきい電流 60mA、直流動作電流 7.5 mA愛調電流周波数120MHzにてとつたもので ある。レーザ発振がオン・オフして凝モード多重 となつてはじめてノイズ抑止効果がでる。 第8図 からノイズ抑止効果が

> > $(75 \text{ mA} - 60 \text{ mA}) \times 2 = 30 \text{ mApp}$

以上で署しく、上記のことを支持する。

なお、第8図において、実線は100%帰還の 場合による曲線を示し、一点鎖線は、2.7%帰還 の場合による曲線を示している。

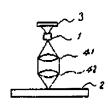
第9図は反射光帰避による半導体レーザノイズ 5 発生を調べる測定系の構成を示す図である。半導 体レーザ1から出た光はレンズ9 Bで平行光束に されてから集光レンズ 91で、デイスク2上に集 光される。半導体レーザ1とデイスク2との間の 距離は約3㎝である。デイスク2は、ポイスコイ ル92によつて光スポツトの焦点深度方向に振動 できるようになつている。レーザ出力は、デイス ク2個とは反対側に出射されるレーザ光を光検出 器3で検出する。光後出器の出力を、CRT93 上に表示したり、ビデオアンプ84で増幅した後、15 ード発振スペクトルを示す図、第6,7,8図は、 スペクトルアナライザ95で周波数分析する。レ ーザ駆動電流は直流激5からの直流分と、高周波 発振器6からの交流分との重ね合わせた電流であ రెం

以上の如く半導体レーザを光源として用いた情 報再生装置において、デイスクからの反射光が半 導体レーザに帰還することによつて生ずるノイズ は、半導体レーザを高周波電流駆動して多重縦モ ード発振させることによって抑止できる。本発明 はSCOOPによる情報再生装置にも、従来還の光 ピツクアップによる情報再生装置にも有効である。 図面の簡単な説明

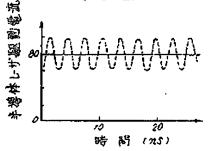
10

第1図は、反射光帰還型の半導体レーザを用い 10 た光ピツクアツプの構成図、第2図は、デイスク 変位に対する半導体レーザ光出力の関係を示した 図、第3図は、半導体レーザの駆動電流の時間変 化を示した図、第4図は本発明の一実施例の構成 を示す図、第5図a~dは、半導体レーザの縦モ ピデオノイズレベルが高濶波駆動により抑止され るととを説明する図、第9図は、半導体レーザの ノイズを測定する測定系の構成を示す図である。

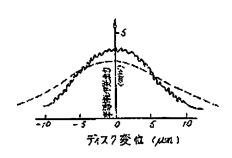
沙口图



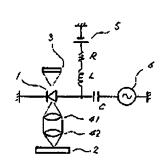
才 3 図

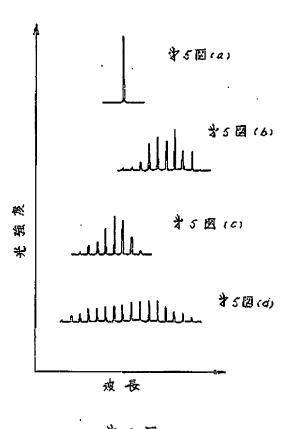


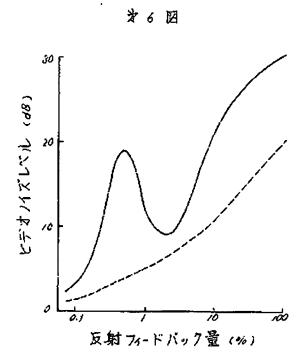
分 2 图

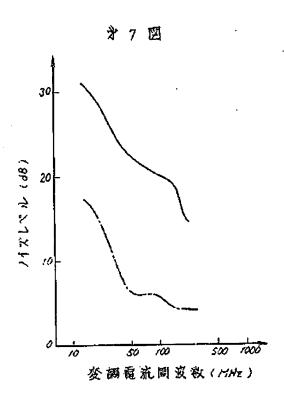


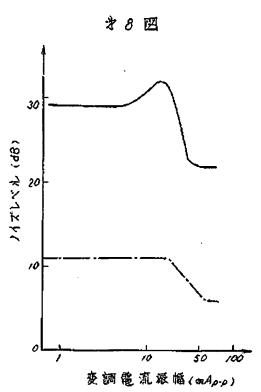
才4四











才 9 図

